

---

2005年6月20日

東北大学 工学研究科

報道関係者各位

**東北大学小池淳一教授が開発した 45nm 世代  
対応の配線プロセスに関する記者発表のご案内**

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

東北大学マテリアル・開発系の小池淳一教授と(株)半導体理工学研究センター(代表取締役社長兼 CEO: 下東 勝博、以下「STARC」)は、45nm 世代以降の LSI 配線において、工程数が短縮でき、デバイス特性と信頼性をともに向上できる新規銅配線プロセスの開発に成功しました。

新しく開発されたプロセスを用いることによって、45nm 対応の高性能・高信頼性配線が実現できるだけでなく、バリア層に高価な金属材料を用いる必要がないこと、バリア層形成工程を省略できること、現状のプロセス装置に適用可能であること、45nm 以前の配線にも適用できること、などコスト的にも多くのメリットが期待できます。

つきましては、同技術開発に関する記者発表を開催し、小池教授が開発した 45nm 世代対応の配線プロセスとその成果をご説明させていただきます。

ご多忙とは存じますが、万障繰り合わせの上、ご来場を賜りますようお願い申し上げます。尚、ご出欠は FAX にて、2005年6月27日(月)までに東北大学工学研究科情報広報室宛てにお送りください。

敬具

## 記

日時 2005年6月28日(火) 13:30 ~ 14:30 (受付開始 13:00)

会場 東北大学 工学研究科(青葉山キャンパス) 総合研究棟 会議室1(201)  
〒980-8579 仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-05  
TEL 022-795-5898

出席者 東北大学教授 小池 淳一

以上

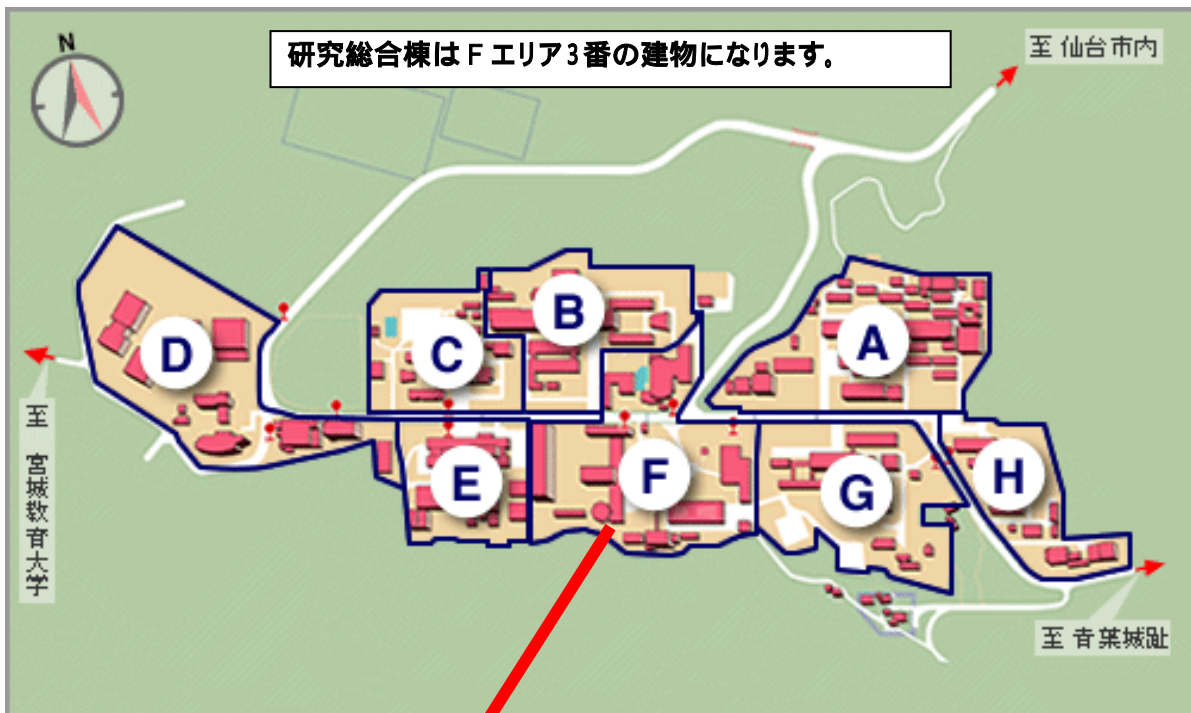
【会見内容に関するお問い合わせ】  
東北大学 工学研究科 知能デバイス材料学専攻  
担当者 小池  
TEL 022-795-7360

【記者発表に関するお問合せ先】  
東北大学 工学研究科 情報広報室  
馬場、河内  
TEL:022-795-5898 FAX:022--795-5898  
E-mail: [eng-pr@eng.tohoku.ac.jp](mailto:eng-pr@eng.tohoku.ac.jp)

<会場案内図>

東北大学 工学研究科(青葉山キャンパス) 総合研究棟 2F 会議室1(201)  
〒980-8579 仙台市青葉区荒巻字青葉6-6

青葉山キャンパス全体図





## 「45nm 世代対応の配線プロセス」記者発表

日時: 2005年6月28日(火) 13:30 ~ 14:30

会場: 東北大学工学研究科(青葉山キャンパス)

総合研究棟 2F 会議室1(201)

ご出席

ご欠席

\*いずれかに印をお付け下さい

ご芳名:

貴社名:

所属:

媒体名:

電話番号:

FAX 番号:

E-mail:

ご出欠のご返信を 6月27日(月) までに FAX にてご返事いただければ幸いです

**FAX 返信先 022-795-5898**